(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-17696

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

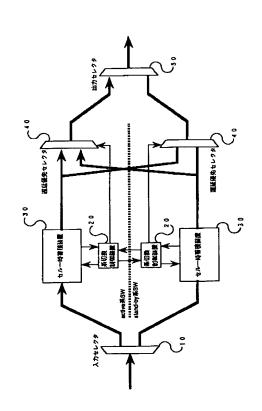
(51) Int.Cl.6	觀別記号	F I
H04L 12	/28	H 0 4 L 11/20 H
H04Q 3	/00	H 0 4 Q 3/00
11,	/04	H 0 4 L 11/20 C
		H 0 4 Q 11/04 M
		審査請求 有 請求項の数5 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特願平9-170847	(71) 出願人 000004237
		日本電気株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)6月27日	東京都港区芝五丁目7番1号
		(71) 出願人 000232254
		日本電気通信システム株式会社
		東京都港区三田1丁目4番28号
		(72)発明者 松村 健次
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(72)発明者 山本 透
	•	東京都港区三田一丁目4番28号 日本電気
		通信システム株式会社内
		(74)代理人 弁理士 岩佐 義幸

(54) 【発明の名称】 ATMリンク切換方式

(57)【要約】

【課題】 ATM網において、セルの遅延品質を保ったまま2重化されたSWの切り換えを行う装置を提供する。

【解決手段】 回線から入力されたセルをアクティブ系 (旧運用系) SWとスタンド・バイ系 (新運用系) SW に振り分ける入力セレクタ10と、系切換時の制御を行う系切換制御装置20と、入力セルを遅延クラス毎に一時蓄積を行うセルー時蓄積装置30と、ある遅延優先クラスのセルをアクティブ系SW及びスタンド・バイ系SWのどちからセルを出力するか選択する遅延優先セレクタ40と、現アクティブ系SWからセルを出力する出力セレクタ50とを具備し、SWの系切換時において、スタンド・バイ系の系切換制御装置20がスタンド・バイ系セルー時蓄積装置30との双方の読出制御をすべて行う。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】遅延優先制御を行い2重化された非同期モ ードのATMスイッチを切り換えるATMリンク切換方 式において、

回線から入力されたセルを、旧運用系のアクティブ系ス イッチと新運用系のスタンド・バイ系スイッチとに振り 分ける入力セレクタと、

前記アクティブ系スイッチからセルを出力する出力セレ クタと、

を具備し、

前記アクティブ系スイッチと前記スタンド・バイ系スイ ッチとのそれぞれが、系切換時の制御を行う系切換制御 装置と、

入力セルを遅延クラス毎に一時蓄積を行うセルー時蓄積 装置と、

遅延優先クラスのセルをアクティブ系スイッチおよびス タンド・バイ系スイッチのどちらからセルを出力するか 選択する遅延優先セレクタと、

を備え、

前記系切換時において、前記スタンド・バイ系スイッチ の前記系切換制御装置が、前記アクティブ系の前記セル 一時蓄積装置と、前記スタンド・バイ系スイッチの前記 セルー時蓄積装置との双方の読出制御を行うことによ `り、前記系切換時においてもセルの遅延品質を保つこと が可能となることを特徴とするATMリンク切換方式。

【請求項2】前記セルー時蓄積装置が、前記セルを各遅 延クラス毎に分離する遅延DEMUXと、前記セルを一 時的かつ各遅延クラス毎に蓄積するためのセルー時蓄積 用メモリと、前記セルの書き込みアドレスを管理するラ イト制御装置と、前記セルの読み出しアドレスを管理す るリード制御装置と、前記各遅延クラス毎の出力セルを 多重する遅延MUXとを備えたことを特徴とする、請求 項1に記載のATMリンク切換方式。

【請求項3】前記遅延DEMUXが、入力セルを遅延ク ラス毎に分離し、前記セルー時蓄積用メモリへ蓄積し、 前記系切換制御装置からの要求で遅延クラス毎にセル送 出を行うことを特徴とする、請求項2に記載のATMリ ンク切換方式。

【請求項4】前記系切換制御装置が、前記セルー時蓄積 装置に蓄積されているセル情報を持ち出力指示を出すセ ル管理部と、どちらのセルー時蓄積装置からセルを出力 させるかの選択を制御するセレクタ制御部と、双方のセ ルー時蓄積装置にどの遅延クラスのセルが蓄積されてお り、どの遅延クラスのセルの読み出しを行うかの調停を 行う他系間通信部とを備えたことを特徴とする、請求項 1~3のいずれかに記載のATMリンク切換方式。

【請求項5】前記セル管理部が、前記他系間通信部を通 じて、自系・他系のセルー時蓄積装置のセル蓄積状況を 監視し、もっとも遅延優先度の高いセルの読み出しを指 示することを特徴とする、請求項4に記載のATMリン 50 ィブ系スイッチからセルを出力する出力セレクタとを具

ク切換方式。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ATM(asyn chronous transfer mode; 非同 期転送モード)網で2重化されたスイッチの系切換方式 に関する。

2

[0002]

【従来の技術】図5は、特開平6-6372号公報に記 10 載された従来のATM網における2重化されたスイッチ SWの構成を示す概略図である。図5では、各セルの遅 延優先品質を保持する為に、遅延クラス毎の一時蓄積を 行い、遅延優先度の高いセル (例えば、CBR) からの 読み出しを行い、遅延優先品質を保持しようとしてい た。しかしSWの系切換時においては、回線からSWへ の入力がアクティブ系(active系)(旧運用系) からスタンド・バイ系(stand-by系)(新運用 系) へ切り替わり、入力セルは一旦スタンド・バイ系の セルー時蓄積装置に一時蓄積され、アクティブ系のセル 一時蓄積装置に蓄積されていたセルがすべて流出した 後、始めてスタンド・バイ系 (新運用系) からのセルの 出力が行われていた。こうすることにより、2重化され たSWの系切換時においてもセルの損失をすることな く、切換が可能となっていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来例では、 通常、セルー時蓄積装置内にセルの蓄積の無い場合は、 問題なく切換を行うことが可能となるが、セルー時蓄積 装置内に少しでもセルの蓄積がある場合、問題が発生し ていた。例えばアクティブ系に遅延優先度の低いセルが 蓄積され、その後、遅延優先度の高いセルが流入してき た時に系切換を行った場合、アクティブ系セルー時蓄積 装置(旧運用系)のセルがすべて流出した後にスタンド ・バイ系セルー時蓄積装置 (新運用系) のセルを流すこ とになる。つまり系切換時に限っては、遅延優先度が無 視され、必ずアクティブ系セルー時蓄積装置(旧運用 系)のセルから流出される。その結果、遅延優先度の高 いセルであってもCDVTが大きくなり、遅延品質が悪 化してしまっていた。

【0004】そこで、本発明の目的は、上記課題を解決 するために、セルの遅延品質を保ったまま2重化された SWの切り換えを行う方式を提供することにある。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明のATMリンク切換方式は、遅延優先制御を 行い2重化されたATMスイッチを切り換えるATMリ ンク切換方式において、回線から入力されたセルを、旧 運用系のアクティブ系スイッチと新運用系のスタンド・ バイ系スイッチとに振り分ける入力セレクタと、アクテ 20

備し、アクティブ系スイッチとスタンド・バイ系スイッ チとのそれぞれが、系切換時の制御を行う系切換制御装 置と、入力セルを遅延クラス毎に一時蓄積を行うセルー 時蓄積装置と、遅延優先クラスのセルをアクティブ系ス イッチおよびスタンド・バイ系スイッチのどちらからセ ルを出力するか選択する遅延優先セレクタとを備え、系 切換時において、ネタンド・バイ系スイッチの系切換制 御装置が、アクティブ系のセルー時蓄積装置と、スタン ド・バイ系スイッチのセルー時蓄積装置との双方の読出 制御を行うことにより、系切換時においてもセルの遅延 品質を保つことが可能となることを特徴とする。

【0006】また、セルー時蓄積装置が、セルを各遅延 クラス毎に分離する遅延DEMUXと、セルを一時的か つ各遅延クラス毎に蓄積するためのセルー時蓄積用メモ リと、セルの書き込みアドレスを管理するライト制御装 置と、セルの読み出しアドレスを管理するリード制御装 置と、各遅延クラス毎の出力セルを多重する遅延MUX とを備えるのが好ましい。

【0007】さらに、遅延DEMUXが、入力セルを遅 延クラス毎に分離し、セルー時蓄積用メモリへ蓄積し、 系切換制御装置からの要求で遅延クラス毎にセル送出を 行うのが好ましい。

【0008】また、系切換制御装置が、セルー時蓄積装 置に蓄積されているセル情報を持ち出力指示を出すセル 管理部と、どちらのセルー時蓄積装置からセルを出力さ せるかの選択を制御するセレクタ制御部と、双方のセル 一時蓄積装置にどの遅延クラスのセルが蓄積されてお り、どの遅延クラスのセルの読み出しを行うかの調停を 行う他系間通信部とを備えるのが好ましい。

【0009】さらに、セル管理部が、他系間通信部を通 じて、自系・他系のセルー時蓄積装置のセル蓄積状況を 監視し、もっとも遅延優先度の高いセルの読み出しを指 示するのが好ましい。

【0010】上記構成により、本発明のATMリンク切 換方式では、セルの遅延品質を保ったまま2重化された SWの切り換えを行う。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施例について図 面を参照して説明する。

【0012】図1は、本発明のATMリンク切換方式の 原理を示すブロック図である。この方式は、回線から入 力されたセルをアクティブ系SWとスタンド・バイ系S Wとに振り分ける入力セレクタ10と、系切換時の制御 を行う系切換制御装置20と、入力セルを遅延クラス毎 に一時蓄積を行う一時蓄積装置30と、ある遅延優先ク ラスのセルをアクティブ系SW及びスタンド・バイ系S Wのどちからセルを出力するか選択する遅延優先セレク タ40と、現アクティブ系SWからセルを出力する出力 セレクタ50とを備える。

【0013】次に、通常動作について説明する。通常動 50 2)となり、系切換時でも遅延品質を保つことが可能と

4

作においては、入力セルはアクティブ系装置内のみを通 過し、スタンド・バイ系へのセルの流入・蓄積はないも のとする。回線からセルが入力されると、入力セレクタ 10でセルをアクティブ系 (運用系) SWへ送出する。 送出されたセルは遅延クラス毎に分割され、遅延クラス 毎にセルー時蓄積装置30に蓄積が行われる。その後、 系切換制御装置20が蓄積されているセルの中から遅延 優先度の高いクラスのセルを優先的に読み出す指示をセ ルー時蓄積装置30に対して行い、遅延優先度の高いセ 10 ルから順次読み出される。遅延優先クラス毎に読み出さ れたセルは、遅延優先セレクタ40を通過し、出力セレ クタ50ではセルは現アクティブ系側を通過し回線へ出 力される。この時はアクティブ系セル一時蓄積装置30 には遅延優先度の低いセルの一時蓄積がなされていると する。この状態において、アクティブ系セルー時蓄積装 置30に蓄積されているセルよりも遅延優先度の高いセ ルが流入し、かつSWの系切換を行ったとする。入力セ レクタ10が切り換わり、入力セルがスタンド・バイ系 SW(新運用系)に対してセルの送信を開始する。ま た、出力セレクタ50もスタンド・バイ系からの出力を 開始する。アクティブ系セルー時蓄積装置30(旧運用 系)には遅延優先度の低いセルが蓄積されており、スタ ンド・バイ系セルー時蓄積装置30 (新運用系)にはそ れよりも遅延優先度の高いセルが蓄積されていく。系切 換制御装置20は、アクティブ系セル一時蓄積装置30 とスタンド・バイ系セル一時蓄積装置30の双方の管理 を行い、両方の装置の中で遅延優先度の高いセルから読 み出しを行う。つまりこの場合では、まずスタンド・バ イ系セルー時蓄積装置30(新運用系)からセルの読出 30 が行われ、スタンド・バイ系セルー時蓄積装置30にア クティブ系セルー時蓄積装置30(旧運用系)に蓄積さ れているセルよりも遅延優先度の高いセルが無くなって から、アクティブ系セルー時蓄積装置30からのセル出 力を行う。遅延セレクタ40では、系切換制御装置20 の制御に従い、各遅延クラス毎にアクティブ系装置(旧 運用系) からの出力あるいはスタンド・バイ系装置(新 運用系) からの出力のどちらを出力セレクタ50へ送信 するかの選択を行う。このようにして、本発明のATM リンク切換方式により、セルの遅延品質を保ったまま2 40 重化されたSWの切り換えを行う方式を提供することが 出来る。

【0014】図2は、本発明の動作を示すブロック図で ある。上述したように、アクティブ系セルー時蓄積装置 に遅延優先度の低いセル (1, 2) が蓄積された状態で 系切換が発生し、その後、遅延優先度の高いセル (3, 4) が流入してきたとすると、本発明では、アクティブ 系セルー時蓄積装置 (旧運用系) 及びスタンド・バイ系 セルー時蓄積装置(新運用系)の双方をまとめて管理し て遅延優先制御を行う為、出力としては(3,4,1,

5

なる。

【0015】図3は、本発明のセルー時蓄積装置30の 実施例の構成を示すブロック図である。このセルー時蓄 積装置30は、入力セルを各遅延クラス毎に分離する遅 延DEMUX31と、入力セルを一時的かつ各遅延クラ ス毎に蓄積するためのセルー時蓄積用メモリ32と、入 カセルの書き込みアドレスを管理するライト制御装置3 3と、入力セルの読み出しアドレスを管理するリード制 御装置34と、各遅延クラス毎の出力セルを多重する遅 延MUX35とを備える。次に、このように構成された 10 回路の動作について説明する。まず、セルが入力される と、遅延DEMUX31はセルの遅延クラスを検出し、 クラス毎に異なるセルー時蓄積用メモリ32へ送出す る。セルー時蓄積用メモリ32では、受信したセルをラ イト制御装置33の示すアドレスへ蓄積する。一方で、 リード制御装置34が系切換制御装置20からリード遅 延クラス情報を受信した場合、その遅延クラスの中で到 着時間の最も早いセルの読み出し指示を行う。さらに、 図3において、セルー時蓄積用メモリ32を各遅延クラ ス毎ではなく、各遅延クラスで共有的に使用すれば、ハ 20 ードウェア量の削減が可能となる。また、セルー時蓄積 用メモリ32をFIFOメモリで構成すれば、ライト制 御装置33及びリード制御装置34のハードウェアを簡 略化することができる。

【0016】図4は、本発明の系切換制御装置20の実施例の構成を示すブロック図である。この系切換制御装置20は、セルー時蓄積装置30に蓄積されているセル情報を持ち出力指示を出すセル管理部21と、どちらのセルー時蓄積装置30からセルを出力させるかの選択を制御するセレクタ制御部22と、双方のセルー時蓄積装置30にどの遅延クラスのセルが蓄積されておりどの遅延クラスのセルの読み出しを行うかの調停を行う他系間通信部23とを備える。このように構成された回路の動作を説明すれば、以下の通りである。セルー時蓄積装置30にセルが蓄積されると、どの遅延クラスのセルがどのくらいの最蓄積されているかがセル管理部21へ通知される。セル管理部21は、他系間通信部23を通じて

6

他系のセルー時蓄積装置30のセル蓄積状態を受信し自 系の情報を送信する。セル管理部21は自系・他系双方 に蓄積されているセルの中で、もっとも遅延優先度の高 いセルの読み出しを指示する。もしそのセルが自系であ れば、自系セルー時蓄積装置30への読み出し指示とセ レクタ制御部22とに自系から読み出す様に指示を行 う。また、他系の場合他系間通信部23を通じて、他系 セルー時蓄積装置30への読み出し指示とセレクタ制御 部22に他系から読み出す様に指示を行う。

0 [0017]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、セルの遅延品質を保ったまま2重化されたSWの切り換えを行う方式を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理を示すブロック図である。

【図2】本発明の動作を示すブロック図である。

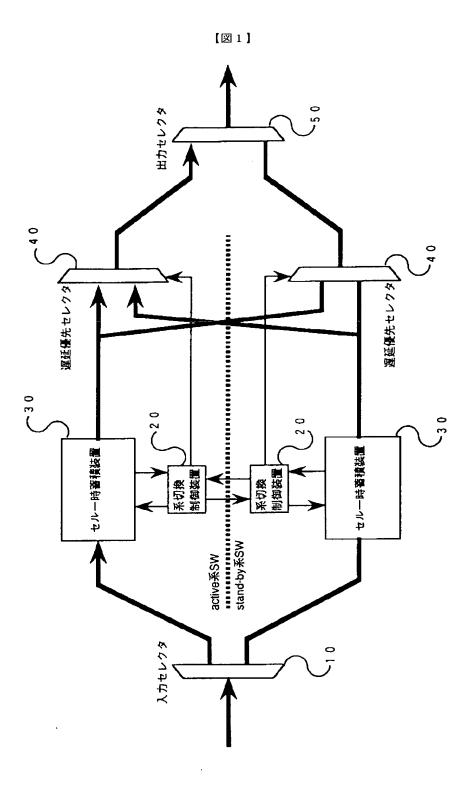
【図3】セルー時蓄積装置の実施例の構成を示すブロック図である。

【図4】系切換制御装置の実施例の構成を示すブロック の 図である。

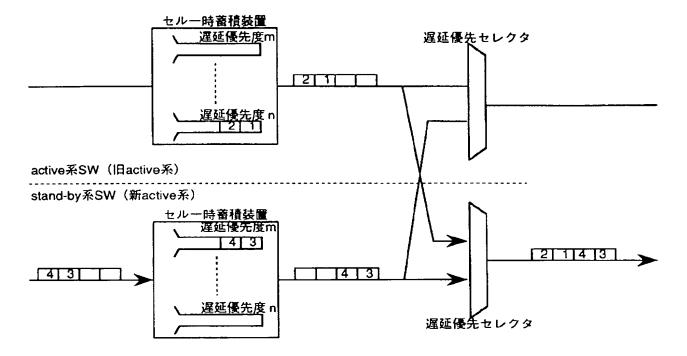
【図5】従来のシステムの構成を示すブロック図である。

【符号の説明】

- 10 入力セレクタ
- 20 系切換制御装置
- 30 セルー時蓄積装置
- 40 遅延優先セレクタ
- 50 出力セレクタ
- 21 セル管理部
- 30 22 セレクタ制御部
 - 23 他系間通信部
 - 31 遅延DEMUX
 - 32 遅延優先クラス
 - 33 ライト制御装置
 - 34 リード制御装置
 - 35 遅延MUX



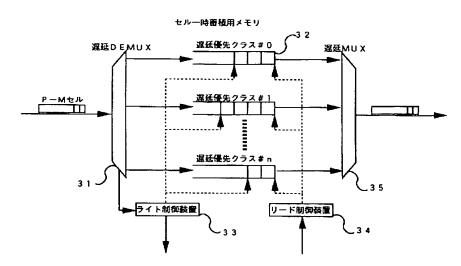
【図2】



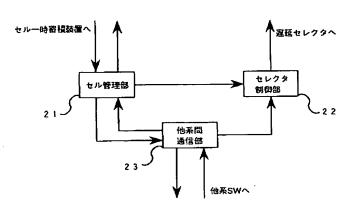
遅延優先度:m>n

□ : ATMセル

【図3】







【図5】

